Ferroelektryczne Pamięci Tranzystorów: Fizyczne Aspekty i Zastosowania - Edycja 2

Indeks: **717841** Producent: **Springer** Kod producenta: **9789811512148**

Cena: **665.23 zł**

Opis

Ferroelectric-Gate Field Effect Transistor Memories: Device Physics and Applications: 131

Producent: Springer

Pamięci tranzystorów z efektem polowym na bazie ferroelektrycznego bramki to niezwykle zaawansowana technologia, która rewolucjonizuje dziedzinę elektroniki. Ta książka oferuje pogłębioną analizę fizyki urządzenia oraz różnorodne zastosowania tej innowacyjnej technologii. Autorzy przedstawiają najnowsze doniesienia naukowe i praktyczne zastosowania pamięci tranzystorów opartych na ferroelektrycznej bramce, otwierając nowe możliwości dla przemysłu elektronicznego.

Podręcznik ten jest nieocenionym źródłem wiedzy zarówno dla studentów i pracowników naukowo-badawczych zajmujących się elektroniką, jak i dla profesjonalistów w przemyśle. Zawiera obszerny opis budowy pamięci tranzystorów z efektem polowym na bazie ferroelektrycznego bramki oraz omawia ich zalety i potencjalne zastosowania w praktyce.

Dzięki tej książce czytelnik dowie się, jak działa technologia pamięci tranzystorów z efektem polowym na bazie ferroelektrycznego bramki oraz jakie korzyści może przynieść w różnych dziedzinach, od elektroniki po przemysłowe zastosowania. To niezwykle wartościowe źródło wiedzy dla wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi technologiami elektronicznymi.

- **temat**: Circuits & components, Electronics engineering, Materials science, Condensed matter physics (liquid state & solid state physics), TECHNOLOGY & ENGINEERING / Electronics / Circuits / General, TECHNOLOGY & ENGINEERING, Electronics, Circuits, General, TECHNOLOGY & ENGINEERING / Electronics / General, TECHNOLOGY & ENGINEERING / Materials Science / Thin Films, Surfaces & Interfaces, Materials Science, Thin Films, Surfaces & Interfaces, SCIENCE / Physics / Condensed Matter, SCIENCE, Physics, Condensed Matter, Electronic Circuits and Systems, Electronics and Microelectronics, Instrumentation, Surfaces, Interfaces and Thin Film, Surface and Interface and Thin Film, HC/Technik/Elektronik, Elektrotechnik, Nachrichtentechnik, HC, Technik, Elektronik, Elektrotechnik, Nachrichtentechnik, HC/Technik/Maschinenbau, Fertigungstechnik, Maschinenbau, Fertigungstechnik, HC/Physik, Astronomie/Atomphysik, Kernphysik, Physik, Astronomie, Atomphysik, Kernphysik, Ferroelectric-gate Field Effect Transistors;Field Effect Transistors with flexible;Inorganic Ferroelectric-gate FETs;NAND-type Memory Circuits;Non-memory Devices;One-Transistor Type;Organic Ferroelectric-gate FETs;Si-Based Ferroelectric-gate FETs;Thin film-Based Ferroelectric-gate FETs, Electronics: circuits and components, Condensed matter physics (liquid state and solid state physics), SCIENCE / Physics / Condensed Matter, SCIENCE / Physics / General, Science/Physics - Condensed Matter, TECHNOLOGY & ENGINEERING / Electronics / Circuits / General, TECHNOLOGY & ENGINEERING / Electronics / General, TECHNOLOGY & ENGINEERING / Materials Science / Thin Films, Surfaces & Interfaces, Technology & Engineering/Electronics - Circuits - General, Technology & Engineering/Materials Science - Thin Films, Surfaces & Interfaces, Circuits & components, Condensed matter physics

(liquid state & solid state physics), Electronic devices & materials, Electronics engineering, Materials science, Surface chemistry & adsorption, Condensed matter physics (liquid state and solid state physics), Electronic devices and materials, Electronics: circuits and components, Elektronik, Materialwissenschaft, Physik der kondensierten Materie (Flüssigkeits- und Festkörperphysik), Schaltkreise und Komponenten (Bauteile), Surface chemistry and adsorption, HC/Physik, Astronomie/Atomphysik, Kernphysik, HC/Technik/Elektronik, Elektrotechnik, Nachrichtentechnik, HC/Technik/Maschinenbau, Fertigungstechnik, Hardcover, Softcover / Technik/Elektronik, Elektrotechnik, Nachrichtentechnik

- **wiążący**: paperback
- **język**: english, english, english
- **waga przedmiotu**: 1.353 pounds
- **strony**: 439
- **słowo kluczowe tematu**: Ferroelectric-gate Field Effect Transistors; Field Effect Transistors with flexible; Inorganic Ferroelectric-gate FETs; NAND-type Memory Circuits; Non-memory Devices; One-Transistor Type; Organic Ferroelectric-gate FETs; Si-Based Ferroelectric-gate FETs; Thin film-Based Ferroelectric-gate FETs, Ferroelectric-gate Field Effect Transistors;Field Effect Transistors with flexible;Inorganic Ferroelectric-gate FETs;NAND-type Memory Circuits;Non-memory Devices;One-Transistor Type;Organic Ferroelectric-gate FETs;Si-Based Ferroelectric-gate FETs;Thin film-Based Ferroelectric-gate FETs, Non-Fiction, SCI/TECH, Science/Math, Singapore
- **kod podmiotu**: PHFC, TJFD, TJFC, TJF, TGM, PHFC, TJFC, PNRX, SCI077000, SCI055000, SCI077000, TEC008010, TEC008000, TEC021040, TEC008010, TEC021040, TJFC, PHFC, TJFD, TJF, TGM, PNRX, 1645, 1684, 1682, 1684
- **grupa docelowa**: General/trade
- **tom**: 131
- **Liczba przedmiotów**: 1
- **numer części**: 9789811512148
- **kolor**: White
- **waga opakowania przedmiotu**: 0.67 kilograms
- **wydanie**: 2nd ed. 2020
- **numer seryjny**: 131
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu**: 9811512140, 9789811512148, 09789811512148
- **producent**: Springer
- **tytuł serii**: Topics in Applied Physics, 131
- **gatunek muzyczny**: Circuits & components, Electronics engineering, Materials science, Condensed matter physics (liquid state & solid state physics), TECHNOLOGY & ENGINEERING, Electronics, Circuits, General, TECHNOLOGY & ENGINEERING, Electronics, General, TECHNOLOGY & ENGINEERING, Materials Science, Thin Films, Surfaces & Interfaces, SCIENCE, Physics, Condensed Matter, HC, Technik, Elektronik, Elektrotechnik, Nachrichtentechnik, HC, Technik, Maschinenbau, Fertigungstechnik, HC, Physik, Astronomie, Atomphysik, Kernphysik, Electronics: circuits and components, Electronics engineering, Materials science, Condensed matter physics (liquid state and solid state physics)
- **Data publikacji**: 2021-03-24T00:00:01Z
- **numer wydania**: 2
- **nazwa przedmiotu**: Ferroelectric-Gate Field Effect Transistor Memories: Device Physics and Applications: 131
- **data premiery**: 2021-03-24T00:00:01Z
- **data uruchomienia strony produktu**: 2021-02-25T05:36:19.112Z

Parametry

Opakowanie	miękka okładka
Rok wydania	2021
Liczba stron	439
Kolor okładki	biały

Język	angielski